



国际电气工程先进技术译丛

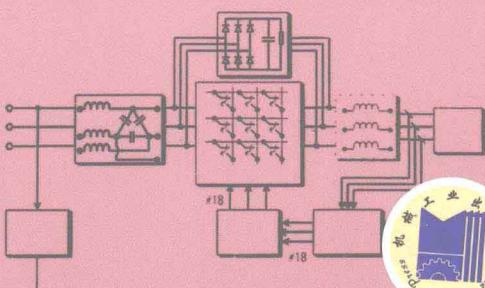
CRC Press
Taylor & Francis Group

电力变流器电路

Power Converter Circuits

William Shepherd
(美) Li Zhang 著

沈经 张正南 译



国际电气工程先进技术译丛

电力变流器电路

(美) William Shepherd 著
Li Zhang
沈 经 张正南 译



机 械 工 业 出 版 社

本书揭示了整流、逆变、周波变流和变流电路的所有关键组分——描述其通断，电压和电流的关系，还有变流器的性质、运行、控制和性能及其实际应用。书中的许多方法基于经典数学，同时包含了大量有解的数字例题。本书主要介绍了单相和三相 AC-DC 整流器电路，功率因数和谐波性能，不同的 DC-AC 逆变器电路，PWM 调制器和相位可控矩阵 AC-AC 周波变流器电路，降压、升压和降升压 DC-DC 变流器电路，以及用于 DC-DC 电路的开关模式变流器电源。

本书深入浅出、通俗易懂，非常适合用作电气工程类专业本科生与研究生的教材，也可作为电气工程师的参考书。

Authorized translation from English language edition published by CRC press, part of Taylor & Francis Group LLC. All right reserved.

本书中文简体字版由机械工业出版社出版，未经出版者书面允许，本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。版权所有，翻印必究。

本书版权登记号：图字 01-2006-6050 号

图书在版编目（CIP）数据

电力变流器电路 / (美) 谢福, (美) 张礼著; 沈经, 张正南译. —北京: 机械工业出版社, 2008. 10
(国际电气工程先进技术译丛)
ISBN 978-7-111-24825-5

I. 电… II. ①谢…②张…③沈…④张… III. 电力系统 - 变流器 - 电路 IV. TM7 TM46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 122255 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)
策划编辑: 牛新国 责任编辑: 牛新国 刘星宁 版式设计: 霍永明
责任校对: 李秋荣 封面设计: 马精明 责任印制: 乔 宇
北京机工印刷厂印刷 (北京樱花印刷厂装订)
2008 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
169mm × 239mm · 24.25 印张 · 469 千字
0 001—4 000 册
标准书号: ISBN 978-7-111-24825-5
定价: 50.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
销售服务热线电话: (010) 68326294
购书热线电话: (010) 88379639 88379641 88379643
编辑热线电话: (010) 88379178
封面无防伪标均为盗版

前　　言

本书可作为大学本科初级和高级电力电子学课程的教科书。通篇运用经典分析。本书主要叙述电力电子学电路，不涉及电力电子学开关的物理特性与制造，也不涉及电力电子学电路保护与辅助元件的设计细节。

本书对整流器电路的论述，比当前教科书中所惯用的方法更易于理解，也更详细。第 14 章讲述通常不被重视的矩阵变流器。第 13 章讲述通常被忽视的周波变流器。本书的特色是包含有大量有解的数字例题、章末问题及其答案。

本书所包含的内容已在英国利兹大学（Leeds University）、布拉德福德大学（Bradford University）和美国俄亥俄州雅典市的俄亥俄大学（Ohio University）用于课堂教学与考试。作者们对能被允许复制成有关材料表示感谢。

本书的一些短章节来源于其中一个作者较早期的工作。笔者感谢英国剑桥大学出版社（Cambridge University Press, England）允许复制这些以前的出版物。

俄亥俄大学电气工程与计算机科学学院的 Janelle Baney、Suzanne Vazzano、Erin Dill、Juan Echeverry、Brad Lafferty 经过多次反复，完成了书稿的录入工作，对此，我们表示深切的谢意。

书稿的大部分计算机文字以及插图是由俄亥俄大学奥尔登（Alden）图书馆的教育媒体服务单位（Instructional Media Service Unit）承担的。在此，我们要感谢该单位的主管 Peggy Sattler，特别感谢研究生助理 Lara Neel，并对他们的专业精神表示由衷的感谢。

最后，由俄亥俄大学教育学院毕业的研究生 Yanling Sun 和 Liangjie Zhu 完成文字校对并将材料存储到计算机磁盘中。

William Shepherd

Li Zhang

目 录

前言

物理量符号表

第 1 部分 AC-DC 变流器 (整流器)

第 1 章 开关和半导体开关	1
1.1 由开关控制功率流	1
1.2 理想开关的属性	2
1.3 实际开关的属性	2
1.4 半导体变流器的类型	3
1.5 半导体开关的类型	5
第 2 章 单向不可控整流器电路	10
2.1 带电阻力性负载的半波不可控整流器电路	10
2.2 带电阻负载的全波二极管电路	21
2.3 带串联 $R-L$ 负载的半波二极管	23
2.4 带串联 $R-L$ 负载的全波二极管电路	28
习题	30
第 3 章 单相可控整流器电路	35
3.1 带电阻力性负载的单相可控电路	35
3.2 带串联 $R-L$ 负载的单相可控整流器	47
习题	60
第 4 章 三相半波不可控 (二极管) 桥式整流器电路	65
4.1 电阻性负载与理想电源	65
4.2 带变压器耦合电源的电阻性负载	70
4.3 大电感性负载与理想电源	71
4.4 在电源阻抗中出现大电感性负载	77
习题	88

第 5 章 三相半波可控桥式整流器电路	91
5.1 电阻性负载与理想电源	91
5.2 带理想电源与并联电容补偿的电阻性负载	99
5.3 大电感性负载与理想电源	102
5.4 串联 R-L 负载与理想电源	110
5.5 串联 R-L 负载加上一个带理想电源的恒定电动势	112
5.6 电源存在阻抗时的大电感性负载	112
习题	118
第 6 章 三相全波不可控桥式整流器电路	121
6.1 电阻性负载与理想电源	121
6.2 大电感性负载与理想电源	129
6.3 电源存在阻抗时的大电感性负载	135
习题	146
第 7 章 带无源负载阻抗的三相全波可控桥式整流器电路	149
7.1 电阻性负载与理想电源	150
7.2 大电感性负载与理想电源	163
7.3 大电感性负载与阻抗电源	170
7.4 总结电源电抗对全波桥式整流器工作（带大电感性负载）的影响	181
习题	182
第 8 章 整流器功率因数和脉宽调制可控整流器电路	186
8.1 三相相控整流桥的功率因数和电源电流的畸变	186
8.2 改善功率因数的方法	187
8.3 脉冲波形的性质	190
8.4 正弦脉宽调制波形的性质	193
8.5 PWM 模式下的三相桥式整流器	196
8.6 例题	199
习题	201

第 2 部分 DC-AC 变流器（逆变器）

第 9 章 三相自然换向可控桥式整流器-逆变器	202
9.1 工作原理	202
9.2 交流系统电感的影响	207
9.3 例题	208
习题	212
第 10 章 三相阶梯波逆变器电路	214
10.1 逆变器电路概述	214
10.2 阶梯波逆变器的电压波形	215
10.3 谐波畸变的量度	224
10.4 6 阶梯电压波的谐波性质	224
10.5 最佳 12 阶梯波的谐波性质	225
10.6 带串联 $R-L$ 负载的 6 阶梯电压逆变器	226
10.7 例题	230
习题	235
第 11 章 三相脉宽调制可控逆变器电路	237
11.1 正弦脉宽调制	237
11.2 加到一个平衡的三相电阻性-电感性负载上的 PWM 电压波形	243
11.3 加到一个三相感应电动机上的 PWM 电压波形	245
11.4 例题	246
习题	253

第 3 部分 AC-AC 变流器

第 12 章 相控周波变流器	254
12.1 引言	254
12.2 单相相控双变流器	255
12.3 三相-单相周波变流器	262
12.4 三相-三相周波变流器	268
习题	276

第 13 章 包络线周波变流器	278
13. 1 单相周波变流器工作	278
13. 2 三相-单相周波变流器	279
13. 3 三相-三相四线包络线周波变流器	281
13. 4 三相-三相三线包络线周波变流器	287
13. 5 例题	287
习题	290
第 14 章 矩阵变流器	291
14. 1 矩阵变流器的工作原理	291
14. 2 矩阵变流器开关	292
14. 3 矩阵变流器电路	293
14. 4 三相电动机应用中 PWM 矩阵变流器开关控制的要点	294
14. 5 实例模拟结果 ^[34]	310
14. 6 小结	311
第 4 部分 DC-DC 变流器	
第 15 章 DC-DC 变流器电路	313
15. 1 降压变流器 (buck 变流器)	313
15. 2 升压变流器 (boost 变流器)	322
15. 3 降压-升压变流器 (buck-boost 变流器)	327
15. 4 直流电动机的直流斩波控制	330
习题	333
第 16 章 开关模式变流器电源	335
16. 1 高频开关	335
16. 2 高频隔离变压器	336
16. 3 推挽变流器	337
16. 4 全桥变流器	339
16. 5 单开关正激变流器	341
16. 6 单开关反激变流器	346
习题	354

VIII 电力变流器电路

附录	356
附录 A	傅里叶级数的一般表达式	356
附录 B	习题的答案	357
参考文献	374

物理量符号表

$A_1 B_1 C_1$	1 阶傅里叶系数
$a_n b_n c_n$	n 阶傅里叶系数
$a_s b_s c_s$	电源端电流的傅里叶系数
e	瞬时电动势 (V)
e_c	瞬时电容电压 (V)
e_L	瞬时电感电压 (V)
e_L	瞬时负载电压 (V)
e_r	瞬时纹波电压 (V)
$e_{ab} e_{bc} e_{ca}$	三相系统中的瞬时线电源电压 (V)
$e_{aN} e_{bN} e_{cN}$	三相系统中的瞬时相负载电压 (V)
$e_{AN} e_{BN} e_{CN}$	三相系统中的瞬时相电源电压 (V)
f	频率 (Hz)
i	瞬时电流 (A)
$i_a i_b i_c$	三相系统中的瞬时线电流 (A)
i_c	瞬时电容电流 (A)
$i_{ca} i_{cb} i_{cc}$	三相系统电容分支中的瞬时电流 (A)
i_L	瞬时负载电流 (A)
i_R	瞬时电阻电流 (A)
i_s	瞬时电源电流 (A)
$i_{sa} i_{sb} i_{sc}$	三相系统线中的瞬时电源电流 (A)
i_{ss}	电流的瞬时稳态分量 (A)
i_t	电流的瞬时暂态分量 (A)
n	谐波次数
p	频率比
t	时间 (s)
I_{min}	最小方均根电源电流 (A)
I_{sc}	短路电流 (A)
\hat{I}	峰值正弦短路电流 (A)
L	自感系数 (H)
L_s	电源线电感的自感系数 (H)

X 电力变流器电路

M	调制比
N	圈数
P	平均功率 (W)
P_a, P_b, P_c	三相系统中每相的平均功率 (W)
P_{in}	平均输入功率 (W)
P_L	平均负载功率 (W)
P_s	平均电源点功率 (W)
PF	功率因数
PF_c	有补偿时的功率因数
PF_{max}	最大功率因数
Q_L	负载功率的无功分量 (VA)
R	电阻 (Ω)
RF	纹波因数
S_L	负载的视在功率 (VA)
T	时间常数 (s)
V	电池的端电压 (V)
X_c	容抗 (Ω)
X_L	感抗 (Ω)
X_{sc}	短路感抗 (Ω)
Z	阻抗 (Ω)
	希腊字符
α	晶闸管的触发延迟角 (rad)
$\alpha\beta$	二极管电池充电电路中导通的限制 (第 2 章) (rad)
α'	电源电感引起的本征延迟角 (rad)
δ	无量纲品质因数
φ	瞬时磁通 (Wb)
ψ	电压与基波电流之间的位移角 (rad)
ψ_n	电压与 n 次谐波电流之间的位移角 (rad)
ψ_s	电压与电源电流之间的位移角 (rad)
μ	重叠角 (rad)
θ	导通角 (rad)
ω	电源角频率 (rad)
Δ	角的小值 (rad)
Φ	电源正弦电流频率的相角 (rad)
Φ_n	n 次谐波频率的正弦电流的相角 (rad)

第1部分 AC-DC 变流器（整流器）

第1章 开关和半导体开关

1.1 由开关控制功率流

在固定的电压源与负载之间的电能量流，常常由位于其间的控制器来控制，如图 1-1 所示。如果要求能流有多样性，那么，从电源看去，负载加上控制器的视在阻抗必须是变化的。相反，从负载看去，电源加上控制器的视在性质必须是可调节的。从任何一方的观点看，功率流的控制可用串接一个具有所要求性能的控制器来实现。如果用一个电流源来替代电压源，那么可并联一个合适的控制器来实现控制。

图 1-1 所示的串接控制器能采取许多不同的形式。在交流配电系统中，功率流的连续可变性是一种二次性要求，电气变压器是经常普遍使用的控制元件。插入电抗性元件是不方便的，因为合适尺寸的可变电感器与电容器既昂贵，也很占空间。要是用一个串接的可变电阻器替代就容易得多，但是要以付出相当大的能量损耗为代价。吸收有效电功率的负载通常具有能量“惯性”。因而，可以有效地影响由插入控制器产生的任何幅度变化。



图 1-1 电源、控制、负载电路框图

由控制器引入的电流幅度与功率流量的变化，可以通过电源接通时间与不接通时间之比的变化来得知。如果开关频率足够快，负载由于它的电气惯性，跟不上开关变化，那么在一个理想的控制器中就没有能量消耗。负载的电气惯

性越大，开关的频率越高，开关的干扰减小得越显著。

1.2 理想开关的属性

一个理想开关的属性大致可以概括如下：

1.2.1 一次属性

- 1) “开通”与“关断”之间的状态转换开关时间应该为零。
- 2) “开通”状态下，开关器件两端的电压降应该为零。
- 3) “关断”状态下，通过开关器件的电流应该为零。
- 4) 功率控制比（即器件的功率处理容量与实现状态转换所要求的控制电极功率之比）应该为无限大。
- 5) “关断”状态下，电压承受容量应该为无限大。
- 6) “开通”状态下，电流处理容量应该为无限大。
- 7) 开关的功率处理容量应该为无限大。

1.2.2 二次属性

- 1) 控制功能与功率流之间完全的电气隔离。
- 2) 双向电流、电压的阻断能力。

一个理想的开关通常如图 1-2 所示。这不是一个通用的图，不同的作者会用不同的图来尝试提供有关开关及其作用的更进一步信息。图 1-2 所示的功率流是双向的，在开通与关断开关时，没有能量消耗。



图 1-2 开关电路框图

1.3 实际开关的属性

电力电子半导体开关基于超纯单晶硅的性质。这种基本材料通过复杂的工艺流程（称为掺杂）形成 p 型（正的）半导体与 n 型（负的）半导体组合在一起的晶圆片。晶圆片的大小取决于半导体开关的电流与电压额定值。晶圆片通常是圆形的，其面积大约是 $1\text{mm}^2/\text{A}$ 。一个 10A 的器件具有的直径大致是 3.6mm，而一个 500A 的装置具有的直径大致是 25mm (1in)。晶圆片通常封装在一个塑料的或金属的外壳中以进行保护，同时外壳也为结或者结的 n 型和 p 型材料所产生的热量提供散热通路。结温是半导体器件最重要的性质。

实际的半导体开关是不完美的。它们具有一定的电阻值，尽管很低，却产生一个导通电压降，虽然它的关断电阻阻值很高，但是也是有限的，因而会导致出现前向和反向漏电流，具体由所用电压的极性决定。

开通与关断（即交换）的操作并不发生在瞬时。每次转换都产生一个有限时间的延迟。开通与关断两者都伴随着热耗散，因而引起器件温度的升高。在控制负载的情况下，器件工作在频繁的开关状态，开通与关断的功率损失加到稳态导通损耗中，组成总的额外耗散损失，这些功率损失通常表现为热。控制电极的操作也在器件中产生功率耗散。

1.4 半导体变流器的类型

按照半导体开关变流器的功能，可将其分为三个主要类型。

- 1) 功率从一个交流电源转换成一个直流形式，这类变流器常被称为整流器。
- 2) 功率从一个直流电源转换成一个交流形式，这类变流器常被称为逆变器。
- 3) 功率从一个交流电源直接转换到一个具有不同频率的交流负载上，这类变流器常被称为周波变流器或矩阵变流器。
- 4) 功率从一个直流电源直接转换到一个具有不同电压的直流负载上，这类变流器常被称为斩波变流器或开关模式变流器。

1.4.1 整流器

整流就是在供电电流到负载之前，将从交流电源来的电流变换为一个单向形式的电流。当负载电流是单向时，交流电源的电流仍保持为双向（见图 1-3）。对于电阻性负载，负载电压的极性是固定的。在交流电源电压的情况下，能量储存性负载的负载电流是单向的、脉冲型的。而在负载电流的周期中，在串联负载的电感元件中的负载电压可能会变化，并改变极性。

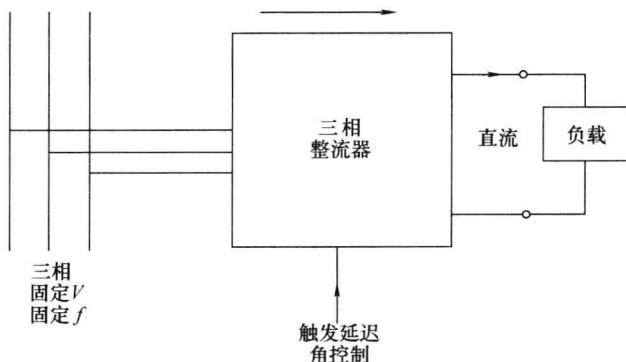


图 1-3 三相整流器电路框图

整流器电路的某些重要特性与电路的拓扑及阻抗性质无关，可分为在整流

器的电源侧和负载侧两组特性。当电源系统具有一个低的（理想地为0）阻抗时，电源电压是正弦波，甚至当整流器从电源汲取非正弦脉冲电流时，还能在很大程度上保持在非畸变状态。对一般电路分析而言，可以假定，半导体整流器件如二极管和可控整流器是理想的开关。在导通期间，它们是无功率耗散的，并具有零电压降。而当加上反向阳极电压时，开关截止，具有无限大的阻抗。

为了探讨整流器电路的某些基本性质，可以简单地从三相电路中分离出单相电路来考虑。另外，把二极管（不可控整流器）电路与晶闸管（可控整流器）电路分开来考虑，把电阻性负载与电抗性负载分开来考虑的分类也是有帮助的。在后续章节中将对其进行阐述。

三相与单相整流器是通过电源侧电压的自然周期来换向（即关断）的。一般说来，整流器没有必要使用门极关断器件作为开关。可控整流器最常使用晶闸管作为开关。只有在特殊的应用中要求电源接受来自负载的再生功率时，才需要使用门极关断器件。

1.4.2 逆变器

从一个直流电源转移功率到一个交流电路的过程被称为逆变过程（见图1-4）。与整流一样，运行由半导体开关器件的可控开关进行。各种形式的逆变器电路及其相关应用在第9~11章中介绍。

1.4.3 周波变流器

功率可以通过半导体器件的直接开通和关断，从一个交流电源传递到另一个通常频率较低的交流负载（见图1-5）。其换向与整流器相同，是通过电源侧

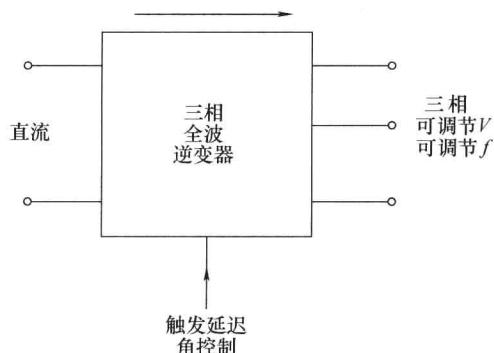


图 1-4 三相全波逆变器电路原理图

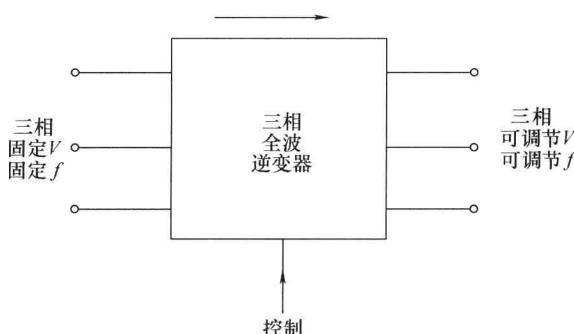


图 1-5 三相周波变流器电路框图

电压的自然周期来进行的。将在第12、13章中给出对于周波变流器电路及其工作原理的详细讨论。

1.5 半导体开关的类型

通常应用的半导体开关的主要类型有：

- 1) 二极管。
- 2) 功率晶体管：
 - a) 双极结型晶体管 (BJT)；
 - b) 金属-氧化物-半导体场效应晶体管 (MOSFET)；
 - c) 绝缘栅双极型晶体管 (IGBT)；
 - d) 静电感应晶体管 (SIT)。
- 3) 晶闸管器件：
 - a) 硅可控整流器 (SCR)；
 - b) 静态感应晶闸管 (SITH)；
 - c) 门极关断 (GTO) 晶闸管；
 - d) MOS 控制晶闸管 (MCT)；
 - e) 三端双向晶闸管 (TRIAC)。

这些器件的一些相关性质的细节汇总见表1-1。

表1-1 各种晶闸管的性能

开关类型	电流	导通	关断	特点
理想开关	双向的	瞬时的	瞬时的	导通阻抗为0
二极管	单向的	正向电压 ($V_A > V_K$)	反向电压 ($V_A < V_K$)	电压启动 低导通态阻抗 低导通态压降 高关断态阻抗
晶闸管				
硅可控整流器 (SCR)	单向的	正向电压 ($V_A > V_K$) 正向门极偏置 $V_G > V_K$	反向电压 ($V_A < V_K$) 以降低电流	不可能用门极关断
静电感应晶闸管 (SITH)	单向的	正向电压 $V_A > V_K$ 导通是常态 (无门极驱动)	去除正向电压 负门极信号 $V_G < V_K$	反向阻断电压低

6 电力变流器电路

(续)

开关类型	电流	导通	关断	特点
门极关断 (GTO) 晶闸管	单向的	正向电压 $V_A > V_K$ 和 +ve 门极脉冲 ($I_G > 0$)	θ ve 门极脉冲 ($I_G < 0$) 或电流减小	当反向阻断电压 低时, 称之为不对称门极关断晶闸管
MOS 控制晶闸管 (MCT)	单向的	正向电压 ($V_A > V_K$) - θ ve 门极脉冲 ($V_G < V_K$)	+ ve 门脉冲 ($V_G > V_A$)	低反向雪崩电压
三端双向晶闸管 (TRIAC)	双向的	正向或反向电压 ($V_A > < V_K$) + ve 或 θ ve 门脉冲	用电压反向与 0 门极信号来使 电流降低	理想的正向与反 向阻断对称 适合于相角触发
晶体管				
双极结型晶体管 (BJT)	单向的	正向电压 $V_A > V_K$ + ve 基极驱动 $V_B > V_E$	去除基极电流 ($I_B = 0$)	级联 2 或 3 个器件 生成一种高增益 (小基极电流) 的达 林顿连接
金属-氧化物-半导体 场效应晶体管 (MOSFET)	单向的	正向电压 $V_D > V_S$ + ve 门脉冲 $V_G > V_S$	去除门驱动 ($V_G = 0$)	非常快的开通与 关断
绝缘栅双极型 晶体管 (IGBT)	单向的	正向电压 $V_C > V_E$ + ve 门脉冲 $V_G > V_S$	去除门驱动 ($V_G = 0$)	低的导通态损耗 非常快的开通/关 断时间 低的反向阻断电 压
静电感应晶体管 (SIT)	单向的	正向电压 $V_D > V_S$ 开通是正常态 ($V_G = 0$)	+ ve 门脉冲 $V_G > V_S$	也称之为高导通 态压降的功率 JFET

1.5.1 二极管

二极管是电压启动型开关, 通过加上正向电压产生电流导通, 而且电流是单向的。二极管是整流器电路开关的基本类型。因为二极管不能被外部的信号所开通或关断, 所以被认为是不可控整流器。在导通期间 (见图 1-6), 其正向电流仅由外部电路的阻抗所决定。导通期间的电压降为 1~2V 的数量级, 因此在许多电力电子学计算中可以被忽略。